

Список публикаций В.А. Бурдова (официальный оппонент):

1. N.V. Derbenyova, V.A. Burdov, “Multi-carrier processes in halogenated Si nanocrystals”, *J. Chem. Phys.* **153**, 114304 (2020).
2. N.V. Derbenyova, A.E. Shvetsov, A.A. Konakov, V.A. Burdov, “Effects of surface halogenation on exciton relaxation in Si crystallites: prospects for photovoltaics”, *Phys. Chem. Chem. Phys.* **21**, 20693 (2019).
3. Н.В. Дербенёва, А.А. Конаков, В.А. Бурдов, “Влияние галогеновой пассивации поверхности на излучательные и безызлучательные переходы в кремниевых нанокристаллах”, *ЖЭТФ* **156**, 283 (2019).
4. E.S. Azarova, G.M. Maksimova, V.A. Burdov, “Massive Dirac fermions in one-dimensional inhomogeneous nanorings”, *Physica E* **106**, 140 (2019).
5. N.V. Derbenyova, V.A. Burdov, “Effect of Doping with Shallow Donors on Radiative and Nonradiative Relaxation in Silicon Nanocrystals: Ab Initio Study”, *J. Phys. Chem. C* **122**, 850 (2018).
6. N.V. Derbenyova, V.A. Burdov, “Radiative decay rates in Si crystallites with a donor ion”, *J. Appl. Phys.* **123**, 161598 (2018).
7. Н.В. Дербенёва, А.А. Конаков, А.Е. Швецов, В.А. Бурдов, “Электронная структура и спектры поглощения нанокристаллов кремния с галогеновым покрытием (Br, Cl)”, *Письма в ЖЭТФ* **106**, 227 (2017).
8. N.V. Derbenyova, A.A. Konakov, V.A. Burdov, “Resonant tunneling of carriers in silicon nanocrystals”, *J. Appl. Phys.* **120**, 134302 (2016).